

Сведения о ведущей организации

Полное наименование и сокращенное наименование	Место нахождения	Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»	Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) (о сотрудниках, которые готовят отзыв ведущей организации)
<p>ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН)</p>	<p>Российская Федерация. Москва.</p>	<p>119991, Москва, Ленинский проспект, 31. +7(495)952-0787 info@igic.ras.ru http://www.igic.ras.ru</p> <p>izotov@igic.ras.ru mgvas@igic.ras.ru</p>	<p>1. Магнитомягкий полупроводниковый материал. В.П. Саныгин, О.Н. Пашкова, А.В. Филатов, А.Д. Изотов, В.М. Новоторцев. Патент на изобретение № 2465378. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений РФ 27 октября 2012 г.</p> <p>2. Патент (Республика Беларусь). Способ получения монокристаллического антимоноида марганца. В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, А.Д. Изотов, М.Л. Малышев, С.Ф. Маренкин Заявитель и патентообладатель: ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», заявл. №a20120380 от 15.03.2012.</p> <p>3. С.Ф. Маренкин, А.В. Кочура, И.В. Федорченко, А.Д. Изотов, М.Г. Васильев, В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, О.А. Новодворский, А.Л. Желудкевич. Выращивание эвтектических композиций в системе InSb–MnSb. // Неорганические материалы. 2016. - Т.52. - №3.- С.309-314.</p> <p>4. В. Г. Яржемский, С. В. Мурашов, А. Д. Изотов. Электронное строение и обменное взаимодействие в магнитных полупроводниках Ga_{1-x}Mn_xAs и In_{1-x}Mn_xSb.// Неорганические материалы. 2016.- Т.52. - № 2. – С.119–123.</p> <p>5. S. F. Marenkin, A. D. Izotov, I. V. Fedorchenko, and V. M. Novotortsev. Manufacture of Magnetic Granular Structures in Semiconductor–Ferromagnet Systems. // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2015, Vol. 60, No. 3, pp. 295–300.</p> <p>6. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, А. Д. Изотов, А. А. Шелякин. Создание и исследование высокотемпературного лазерного диода с длиной волны излучения 1310 нм на основе зарощенных гетероструктур InP/GaInAsP//Неорганические материалы, 2014. -Т 50, № 9, с. 963–967.</p>

		<p>7. O. N. Pashkova, A. D. Izotov, V. P. Sanygin, and A. V. Filatov. Ferromagnetism of GaSb (2% Mn) Alloy// Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2014, Vol. 59, No. 11, pp. 1324–1327.</p> <p>8. I.V. Fedorchenko, A.N. Aronov, L.Kilanski, V. Domukhovski, A. Reszka, B.J. Kowalski, E. Lahderanta, W. Dobrowolski, A.D. Izotov, S.F. Marenkin. Phase equilibria in the ZnGeAs₂–CdGeAs₂ system// Journal of Alloys and Compounds. 2014, Vol. 599. P.121–126.</p> <p>9. В.Г. Яржемский, А.Д. Изотов. Электронное строение и структура параметра порядка в высокотемпературных сверхпроводниках на основе оксидов меди и пниктидов железа.//Неорганические материалы.- 2014. - Т.50.- №9.- С. 983-987.</p> <p>10. M. G. Vasil'ev, A. M. Vasil'ev, A. D. Izotov, Ya. G. Filatov, and A. A. Shelyakin. Fabrication and Parameters of a 1310 nm Buried Heterostructure Operating in the Microwave Region// Inorganic Materials, 2013, Vol. 49, No. 6, pp. 539–544.</p> <p>11. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, А. Д. Изотов, А. А. Шелякин. Создание и исследование лазерного диода для удаленного определения концентрации метана.// Неорганические материалы, 2012, том 48, № 3, 305–311.</p> <p>12. О.Н. Пашкова, В.П. Саныгин, А.В. Филатов, Н.Н. Ефимов, А.Д. Изотов. Магнитомягкий полупроводник InSb<Mn,Zn> с температурой Кюри 320 К.// Журнал неорганической химии. 2012. Т.57. №7. С. 1073–1075</p>
--	--	--

Заверяю:
Ученый секретарь ИОНХ РАН, д.х.н.

М.Н. Бреховских

М.Н. Бреховских

